
	FQB1N60TM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQB1N60TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQB1N60TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 1590 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQB1N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1590 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 1.2A (Tc) 3.13W (Ta), 40W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	1.2A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	11.5 Ohm @ 600mA, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	6nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds On} , Min R _{ds On})	10V
V _{gs} (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
















FQB1N60TM ist neu im Original, Suche FQB1N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB1N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB1N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQB20N06 FSC FSC TO-263</p>	 <p>FQB1N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p>	 <p>FQB20N06L VB FQB20N06L VB</p>
 <p>FQB1N60 FAIRCHILD FQB1N60 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB1P50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK</p>	 <p>FQB1P50TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK</p>	 <p>FQB19N20LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQB13N50CTM	 FQB13N50CTM	 FQB140N03L	 FQB14N30TM	 FQB14N30TM
 FQB16N25TM	 FQB16N25TM	 FQB17P06	 FQB17P10	 FQB17P10TM
 FQB17P10TM	 FQB19N10L	 FQB19N10LTM	 FQB19N10LTM	 FQB19N10TM
 FQB19N10TM	 FQB19N20	 FQB19N20C	 FQB19N20CTM	 FQB19N20CTM
 FQB19N20L	 FQB19N20LTM	 FQB19N20LTM	 FQB19N20TM	 FQB19N20TM
 FQB1N60TM	 FQB20N06L	 FQB20N60FTM	 FQB20N60TM	 FQB22P10
 FQB22P10TM	 FQB22P10TM	 FQB22P10TM_F085	 FQB24N08TM	 FQB24N08TM
 FQB25N33	 FQB25N33TM	 FQB25N33TM	 FQB25N33TM_F085	 FQB27N25TM
 FQB27P06	 FQB27P06TM	 FQB27P06TM	 FQB2N50C	 FQB2N60TM
 FQB2N60TM	 FQB2N80TM	 FQB2N80TM	 FQB2NA90TM	 FQB2NA90TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited